

Кондаков Михаил Николаевич

«Омические контакты на основе системы металлизации Mo/Al/Mo/Au к гетероструктурам
AlGaIn/GaN»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность **05.27.06** – «Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов электронной техники»

Работа выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников федерального автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

Научный руководитель: д.ф.-м.н., заведующий кафедрой полупроводниковой электроники и физики полупроводников «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Диденко Сергей Иванович.

Экспертная комиссия:

1. Ховайло Владимир Васильевич – д.ф.-м.н., доцент, в.н.с. кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Мурашев Виктор Николаевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС»;
3. Бублик Владимир Тимофеевич – д.ф.-м.н., профессор кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков НИТУ «МИСиС»;
4. Якимов Евгений Борисович – д.ф.-м.н., заведующий лабораторией локальной диагностики полупроводниковых материалов федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук;
5. Слепцов Владимир Владимирович – д.т.н., заведующий кафедрой радиоэлектроника, телекоммуникации и нанотехнологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)».

Ведущее предприятие:

Акционерное Общество «НИИМЭ»

Защита диссертации состоится «20» февраля 2020 года по адресу 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 4